

全国半导体设备和材料标准化 技术委员会材料分技术委员会

半材标委[2023]1号

关于延期召开 2022 年度全国半导体设备和材料标准化技术委员会 材料分技术委员会年会的通知

各位委员、各会员单位及相关单位：

因疫情防控要求，原定于 2022 年 11 月 21 日～11 月 24 日在江苏省徐州市召开的 2022 年度全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会年会（见半材标委[2022]26 号）延期至 2023 年 2 月 21 日～2 月 24 日举行，会议地点变更为徐州博顿温德姆酒店，请全体委员务必出席会议，同时请各会员单位、各起草单位及相关单位派代表参会。现将会议有关事宜通知如下：

一、 会议日程和会议内容

1、2 月 21 日，全天报到。

2、2 月 22 日，上午 8:30～12:00 举行全体大会，会议内容如下：

① 领导讲话。

② 全国半导体材料标准化分技术委员会秘书处作 2022 年度工作报告。

③ 表彰 2022 年度全国半导体材料分标委会“技术标准优秀奖”、“特殊贡献奖”和“先进工作者”。

④ 行业技术交流及研讨。

3、2 月 22 日，下午 14:00～18:00 继续全体大会，会议内容如下：

① 终审 2022 年度审定完成的标准项目，审议半导体材料标准体系。

② 论证 2023 年度半导体材料标准计划项目。请所有项目提出单位按照《关于征集 2022 年度全国半导体材料标准化分技术委员会年会论证的标准计划项目的通知》（半材标委[2022]20 号）的要求，提前准备相关论证材料。秘

秘书处将于年会前汇总所有需要论证的新计划项目，会议期间原则上不再接收新项目建设。

4、2月23日，上午8:30开始分组会议，会议内容如下：

对《高纯镓》等12项半导体材料国家和行业标准进行讨论（具体项目见附件）。请各标准负责起草单位于2月16日前将相关标准稿件发送至秘书处邮箱(tc203sc2@cnsmq.com)，由秘书处挂网征求意见。各相关单位可于2月20日之后在有色标准信息网(www.cnsmq.com)“标准制定工作站”栏目下载会议资料。

5、2月24日早餐后返程。

二、报到时间、地点及乘车路线

1、报到时间：2023年2月21日。

2、报到地点：徐州博顿温德姆酒店（徐州市云龙区龙湖西路16号，电话：0516-81918888）。

3、乘车路线：①徐州东站：乘坐90路公交车至金龙湖广场站下车，步行约200米到达酒店；乘出租车约5公里，约10元。②徐州站：乘坐地铁1号线至乔家湖地铁站下车，步行约1200米到达酒店；乘出租车约8公里，约20元。③徐州观音国际机场：乘坐机场大巴1号线至徐州汽车总站，换乘地铁1号线至乔家湖地铁站下车，步行约1200米到达酒店。乘出租车约45公里，约90元。

三、会务及联系人

本次会议由徐州市经济技术开发区管理委员会、徐州经开区科技镇长团、中国电子科技集团公司第四十六研究所和江苏鑫华半导体科技股份有限公司共同协办。

会议期间，食宿统一安排，宿费自理。

标委会秘书处：李素青 010-62565659 15652368697。

会议会务组：18709316115（会议会务）、010-62257692（缴费、发票）。

四、会议报名及缴费

请参会代表务必于2023年2月16日前登录会议报名系统(<http://www.ysmeeting.net>)注册、完善个人信息、住房需求及单位发票信息。本次会议收取会议费850元/人。为有效保障会议用房安排和会议资料的准备，

2月16日之后及现场缴费收取1200元/人。汇款请注明：半材年会（个人汇款请备注单位名称）。汇款账户信息如下：

收款单位：有色金属技术经济研究院有限责任公司

开户行：中国光大银行北京中关村支行

账号：0875 0812 0100 3010 18526

附件：讨论的标准项目

二〇二三年一月十七日



抄报：全国半导体设备和材料标准化技术委员会

附件：

讨论的标准项目

序号	计划文号及编号	项目名称	主编单位	备注
第一组				
1	国标委发[2021]41 号 20214648-T-469	高纯镓	有研国晶辉新材料有限公司	讨论
2	国标委发[2021]23 号 20213238-T-469	碳化硅晶体材料缺陷图谱	东莞市天域半导体科技有限公司	讨论
3	国标委发[2021]23 号 20213239-T-469	蓝宝石图形化衬底片	广东中图半导体科技股份有限公司	讨论
4	国标委发[2021]41 号 20214653-T-469	半导体器件 功率器件用碳化硅同质外延片缺陷的无损检测识别判据 第 1 部分：缺陷分类	中国电子科技集团公司第十三研究所	讨论
5	国标委发[2021]41 号 20214649-T-469	半导体器件 功率器件用碳化硅同质外延片缺陷的无损检测识别判据 第 2 部分：缺陷的光学检测方法	中国电子科技集团公司第十三研究所	讨论
6	国标委发[2021]41 号 20214654-T-469	半导体器件 功率器件用碳化硅同质外延片缺陷的无损检测识别判据 第 3 部分：缺陷的光致发光检测方法	中国电子科技集团公司第十三研究所	讨论
第二组				
7	国标委发[2021]41 号 20214650-T-469	硅中代位碳含量的红外吸收测试方法	中国电子科技集团公司第四十六研究所	讨论
8	国标委发[2021]41 号 20214647-T-469	半导体晶片近边缘几何形态评价 第 1 部分：高度径向二阶导数法（ZDD）	山东有研半导体材料有限公司	讨论
9	国标委发[2022]17 号 20220133-T-469	埋层硅外延片	南京国盛电子有限公司	讨论
10	工信厅科函[2021]291 号 2021-1758T-YS	二氧化碳排放核算与报告要求多晶硅企业	中国恩菲工程技术有限公司	讨论
11	工信厅科函[2021]291 号 2021-1759T-YS	多晶硅企业能源管理中心技术规范	新特能源股份有限公司	讨论
12	工信厅科函[2021]291 号 2021-1760T-YS	多晶硅行业能源管理体系实施指南	新特能源股份有限公司	讨论